

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Планарная технология полупроводников.....	7
Глава 2. Взаимодействие корпускулярных потоков с твердым телом.....	20
2.1. Основные объекты корпускулярно-фотонной технологии. Тормозная способность и пробег ионов.....	20
2.2. Ионное распыление и внедрение.....	35
2.3. Радиационное дефектообразование.....	43
2.4. Технологические особенности ионного внедрения.....	45
2.5. Каналирование ионов.....	48
Глава 3. Взаимодействие электронных потоков с твердым телом.....	53
Глава 4. Физико-химические превращения в низкотемпературной плазме.....	58
4.1. Основные характеристики газоразрядной плазмы.....	59
4.2. Движение заряженных частиц в плазме.....	62
4.3. Плазма в электрическом и магнитном поле.....	65
4.4. Плазмохимические превращения и реакции.....	68
Глава 5. Осаждения пленок в процессе ионно-плазменного распыления.....	74
<i>Приложение 1. Химическое осаждение из газовой фазы.....</i>	<i>91</i>
<i>Приложение 2. Диффузионные процессы.....</i>	<i>97</i>
Задания и таблицы к Приложениям 1, 2.....	107
Библиографический список.....	113